

EC1100P 超薄型620nF电容阵列

产简介

特性

- 620nF电容阵列，五个端子（3x 101nF，134nF，185nF）
- AC / DC偏置变化极低
- 占用空间2.53mm x 0.6mm
- 超薄型150μm
- ESL（等效串联电感）和ESR（等效串联电阻）极低
- 工作温度范围内稳定性高
- 低漏电流
- 无铅铜表面处理，兼容自动或手动回流焊。可根据要求提供其他端接。
- 工作温度范围：-55°C至+125°C

应用

- 配电网的去耦电容
- 稳压器（VR）的旁路电容
- 抑制电源噪声
- 保障高速IC的电源完整性
- 保障高速接口的信号完整性
- 抑制高频噪声
- 其他要求超薄型的应用场合

简述

● EC1100P

ECAP是一款620nF的高性能、超薄型电容阵列，用于保障高di / dt SoC和高速通信SoC的电源完整性和信号完整性。该电容阵列具有极低的ESL（等效串联电感）和ESR（等效串联电阻），高频性能出色，适合用作电源的去耦电容和高速数字SoC的旁路电容。

●

EC1100P提供五个输出端的总电容，可以灵活地为不同应用提供所需电容。例如，合并EC1100P的输出端，可形成三个输出去耦电容，分别用于安普沃尔EP70xx系列IVR的三个输出端，分别为235nF，102nF和185nF。

● EC1100P的厚度极低（150

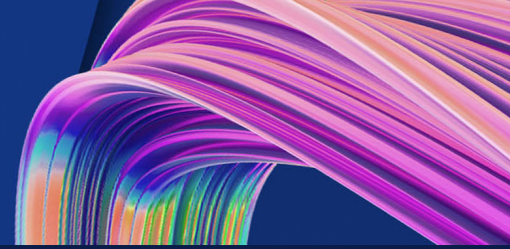
μm，不包括焊盘），可用于严格限高条件的高级组装（处理器封装、BGA侧面封装、嵌入式封装等）。

安普沃尔的硅电容器产品行业领先，工作电压和温度范围内的稳定性极高。因此，

ECAP电容不会像MLCC一样降额运行。单个220nF

ECAP的有效电容与400nF X5R MLCC相当

Empower Semiconductor Confidential



EC1100P 超薄型620nF电容阵列

产简介

资料信息声明和法律免责声明

预告信息（工程原型，可提供少量样品）或初步信息（预生产或首次生产）旨在向客户提供产品线的补充信息，这些产品仍然处于“预生产”状态。预告性能数据可一定程度上反映“量产”状态的性能数据，但以上信息细节如有更改，恕不另行通知。请与您当地的销售处联系，获取产品当前状态和最新规格的详细信息。

安普沃尔半导体科技有限公司
1164 Cadillac Ct.
Milpitas, CA 95035

版权所有 © 2021 安普沃尔半导体科技有限公司

安普沃尔产品仅通过简述出售。安普沃尔半导体科技有限公司保留随时更改电路设计、软件和/或规格的权利，恕不另行通知。请注意，下单前务必核实数据手册是否为最新版本。安普沃尔尽力提供准确和可靠的信息。但是，安普沃尔或其子公司，对使用该信息的行为不承担任何责任；对使用该信息而导致的任何专利侵权或对第三方的侵权不承担任何责任。安普沃尔或其子公司的任何专利或相关权利，均不以暗示或其他方式授予任何许可。

欲知更多安普沃尔半导体科技有限公司及其产品的信息，请访问www.empowersemi.com。

Empower Semiconductor Confidential